



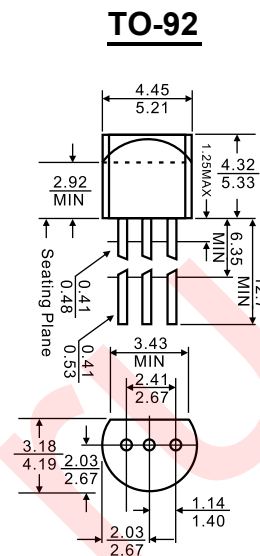
1. ЭМИТТЕР
2. БАЗА
3. КОЛЛЕКТОР

Особенности

- ✧ Высокая суммарная мощность рассеивания ($P_K=0.45\text{Вт}$).
- ✧ Высокий $h_{21Э}$ и хорошая линейность.
- ✧ Комплемментарная пара S9015.

Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации при Токр. среды=25°C.

Обознач	Параметр	Значение	Ед.изм.
Uкб max	Напряжение коллектор-база	50	В
Uкэ max	Напряжение коллектор-эмиттер	45	В
Uэб max	Напряжение эмиттер-база	5	В
Iк max	Постоянный ток коллектора	0.1	А
Pк max	Рассеиваемая мощность коллектора	0.45	Вт
T _J	Рабочая температура перехода	150	°C
T _{stg}	Диапазон температур хранения	-55-150	°C



Размеры в дюймах (миллиметрах).

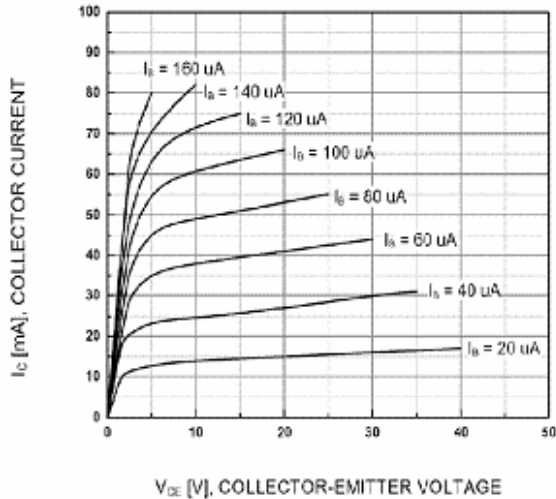
Электрические характеристики (Токр. среды=25°C, если не указано иное).

Параметр	Обозначение	Условия испытания	Мин	Тип	Макс	Ед.изм.
Коллектор-база напряжение пробоя	U _{КБ(ПРОБ)}	I _К =100мкА, I _Э =0	50			В
Коллектор-эмиттер напряжение пробоя	U _{КЭ(ПРОБ)}	I _К =1мА, I _Б =0	45			В
Эмиттер-база напряжение пробоя	U _{ЭБ(ПРОБ)}	I _Э =100мкА, I _К =0	5			В
Коллектор-база ток отсечки	I _{КБО}	U _{КБ} =50В, I _Э =0			0.1	мкА
Коллектор-эмиттер ток отсечки	I _{КЭО}	U _{КЭ} =35В, I _Б =0			0.1	мкА
Эмиттер ток отсечки	I _{ЭБО}	U _{ЭБ} =5В, I _К =0			0.1	мкА
DC коэффициент усиления по току	h _{21Э}	U _{КЭ} =5В, I _К =1мА	60		1000	
Коллектор-эмиттер напряжение насыщения	U _{КЭ(нас)}	I _К =100мА, I _Б =5мА			0.3	В
База-эмиттер напряжение насыщения	U _{БЭ(нас)}	I _К =100мА, I _Б =5мА			1	В
Граничная частота	f _{ГР}	U _{КЭ} =5В, I _К =10мА f=30МГц	150			МГц

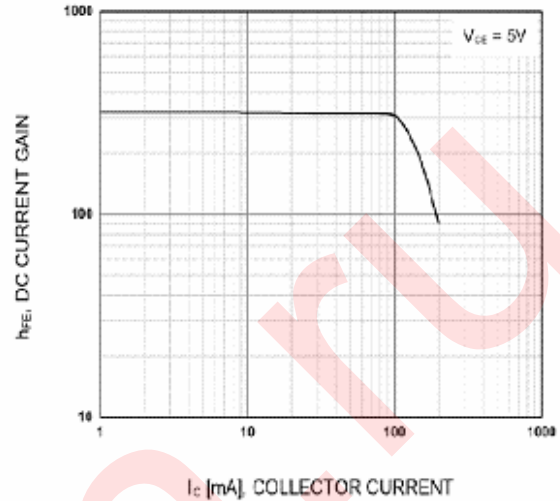
КЛАССИФИКАЦИЯ h_{21Э}

Обозначение	А	В	С	Д
Диапазон	60-150	100-300	200-600	400-1000

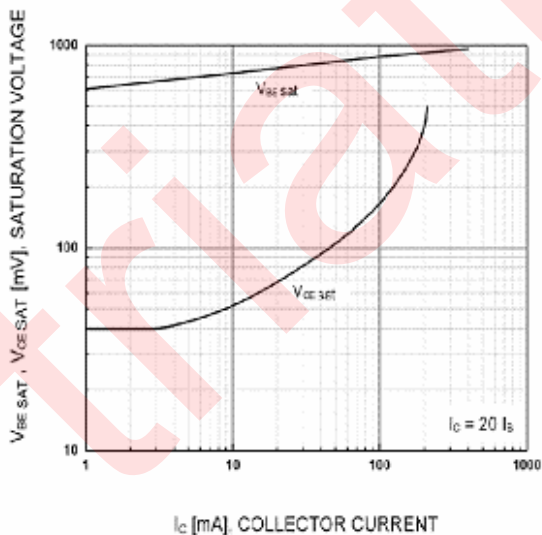
Типичные характеристики



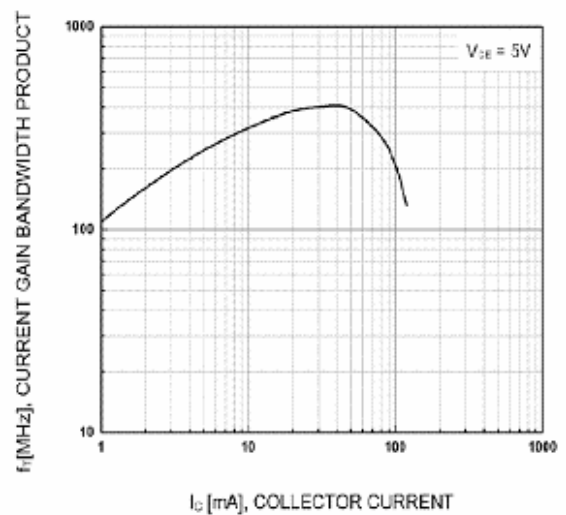
Static Characteristic



DC current Gain



**Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage**



Current Gain Bandwidth Product